



® 平成 29 年 1 月 16 日 (月)

No. 14362 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

特許査定不服審判不成立審決取消訴訟

(「半導体発光装置に成長させたフォトニック結晶」新規性該当事件)

[上] (全2回)

—平成27年(行ケ)第10145号、平成28年7月28日判決言渡—

本願発明は、本願発明の「n型領域とp型領域の間に配置されて波長λの光を放出するように構成された発光層を含み、上面と下面を有する半導体構造」「の前記上面と前記下面は、前記フォトニック結晶によって割り込まれていない」との発明特定事項は、フォトニック結晶と、フォトニック結晶によって割り込まれていない上面又は下面となるp型領域とを成長によって連続的に形成する態様のみならず、両者を個別に形成した上で結合する態様も含むものと解することができるとし、引用発明2の「n-GaAs基板41及び多層膜反射鏡42、並びにクラッド層49、多層膜反射鏡48及びp-GaAsキャップ層47



創業1923年

杉村萬国特許事務所

SUGIMURA International Patent & Trademark Attorneys

所長・弁理士 杉村 憲司

杉村 興作
粟野 晴夫
坪内 伸
結城 仁美
伊藤 怜愛
坂本 晃太郎
石井 裕充
阿部 拓郎
大島 かおり

塚中 哲雄
河合 隆慶
福尾 誠
山口 雄輔
石川 雅章
酒匂 健吾
高木 義和
井上 高雄
田中 睦美

澤田 達也
中山 健一
片岡 憲一郎
前田 勇人
永久保 宅哉
加藤 正樹
鈴木 俊樹
辻 啓太
宮谷 昂佑

富田 和幸
寺嶋 勇太
岡野 大和
小松 靖之
田中 達也
朴 瑛哲
藤本 一
門田 尚也

大倉 昭人
吉田 憲悟
吉澤 雄郎
福井 敏夫
色部 暁義
甲原 秀俊
内海 一成
塩川 未久

鈴木 治
下地 健一
池田 浩
神 紘一郎
田浦 弘達
太田 昌宏
市枝 信之
橋本 大佑

齋藤 恭一
村松 由布子
川原 敬祐
高橋 林太郎
柿沼 公二
真能 清志
君塚 絵美
鈴木 麻菜美

所員171名うち弁理士60名

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館36階 E-mail: k.sugimura@sugi.pat.co.jp

電話: 03-3581-2241(代表) FAX: 03-3580-0506 URL: <http://sugi.pat.co.jp/>

にはホール列は形成されておらず、また、 n -GaAs 基板41の下面及び p -GaAs キャップ層47の上面とはともに平面となって」いることは、仮に、引用例の第2実施例の記載に基づいてホール列がエッチングで形成されたものであるとしても、本願発明の「前記半導体構造の前記上面と前記下面は、前記フォトリソニック結晶によって割り込まれていない」ことに相当するものと認められるとして、本願発明は、引用発明2と同一であるとした審決は誤りがなく、原告の請求が棄却された事例である。

第1 事件の骨組

1 特許請求の範囲記載

本件補正前の本願の特許請求の範囲の記載（請求項の数は48）のうち、請求項32の記載は、以下のとおりである（以下、本件補正前の請求項32に係る発明を「本願発明」という。また、本願の明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。）。

「【請求項32】

n 型領域と p 型領域の間に配置されて波長 λ の光を放出するように構成された発光層を含み、上面と下面を有する半導体構造と、第1の屈折率を有する半導体材料の複数の領域、及び前記第1の屈折率とは異なる第2の屈折率を有する材料の複数の領域、を含み、前記第2の屈折率を有する材料の領域が、前記半導体材料の領域の間にアレイの形に配置され、第2の屈折率を有する材料の各領域が、第2の屈折率を有する材料の最も近い隣の領域から 5λ 未満に位置している、前記半導体構造内に配置されたフォトリソニック結晶と、を含み、前記発光層は、前記フォトリソニック結晶内に配置され、前記半導体構造の前記上面と前記下面は、前記フォトリソニック結晶によって割り込まれていない、ことを特徴とする装置。」

2 審決の理由

審決の理由の要旨は、①本件補正は、平成18年法律第55号による改正前の特許法（以下、単に「改正前特許法」という。）17条の2第4項の規定を満たしていないものであるので、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものであり、また、本願補正発明は、本願優先日前に頒布された刊行物である特開平10-284806号公報（引用例）に記載された発明（引用例の「第3実施例」に関する発明。引用発明1）と同一であり、特許法29条1項3号に該当し、特許出願の際、独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、上記にかかわらず、同法17条の2第5項において準用する同法126条第5項の規定に違反するので、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである、②本願発明は、引用例に記載された発明（引用例の「第2実施例」に関する発明。引用発明2）と同一であり、特許法29条1項3号に該当するから、特許を受けることができないというものである。審決が認定した引用発明2並びに本願発明と引用発明2との一致点及び一応の相違点は、以下のとおりである（なお、本件訴訟において、原告は、上記①の本件補正の却下の判断の誤りについては、取消事由としては主張していない。本判決中の裁判所の判断の中で、敢えて、審決の補正却下の判断に誤りがなかったことを言及している。）。

(1) 審決が認定した引用発明2（省略）

(2) 審決が認定した本願発明と引用発明2との一致点及び相違点

ア 一致点

「 n 型領域と p 型領域の間に配置されて波長 λ の光を放出するように構成された発光層を含み、上面と下面を有する半導体構造と、第1の屈折率を有する半導体材料の複数の領域、及び前記第1の屈折率とは異なる第2の屈折率を有する材料の複数の領域、を含み、前記第2の屈折率を有する材料の領域が、前記半導体材料の領域の間にアレイの形に配置され、第2の屈折率を有する材料の各領域が、第2の屈折率を有する材料の最も近い隣の領域から 5λ 未満に位置している、前記半導体構造内に配置されたフォトリソニック結晶と、を含み、前記発光層は、前記フォトリソニック